



特点

- 芯片与底板电气绝缘，2500V交流电压
- 国际标准封装：全压接结构，优良的温度特性和功率循环能力
- 350A以下模块皆为强迫风冷，400A以上模块，风冷，水冷先用

典型应用

- 交直流电机控制，各种整流电源
- 工业加热控制，调光，无触发点开关
- 电机软起动，静止无功补偿
- 电焊机，变频器，UPS电源，电池充放电

I _{T(AV)}	110A
V _{DRM/V_{RRM}}	500-2500V
I _{TSM}	2.0 KA
I ² t	20 10 ³ a ² s

符号	参数	测试条件	结温 T _J (°C)	参数值			单位
				最小	典型	最大	
I _{T(AV)}	通态平均电流	180° 正弦半波，50HZ 双面散热，T _C =85°C	125			110	A
I _{T(RMS)}	方均根电流		125			173	A
V _{DRM} V _{RRM}	断态重复峰值电压 反向重复峰值电压	V _{DRM} &V _{RRM} tp=10ms V _{DSM} &V _{RSM} =V _{DRM} &V _{RRM} +200V	125	500		2500	V
I _{DRM} I _{RRM}	断态重复峰值电流 反向重复峰值电流	V _{DM} =V _{DRM} V _{RM} =V _{RRM}	125			20	mA
I _{TSM}	通态不重复浪涌电流	10ms 底宽，正弦半波 V _R =0.6V _{RRM}	125			2.40	KA
I ² t	浪涌电流平方时间积					29	A ² S*10 ³
V _{TO}	门槛电压		125			0.8	V
r _T	斜率电阻					2.29	mΩ
V _{TM}	通态峰值电压	I _{TM} =330A	25			1.15	V
dv/dt	断态电压临界上升率	V _{DM} =0.67V _{DRM}	125			800	V/us
di/dt	通态电流临界上升率	I _{MT} =52A 门极触发电流幅值 I _{GR} =1.5A 门极电流上升时间 t _r ≤0.5us	125			100	A/us
I _{GT}	门极触发电流	V _A =12V,I _A =1A	25	30		100	mA
V _{GT}	门极触发电压			1.0		2.5	V
I _H	维持电流			20		150	mA
V _{GD}	门极不触发电压	V _{DM} =0.67V _{DRM}	125			0.2	V
R _{th(j-c)}	热阻抗（结至壳）	180° 正弦波，单面散热				0.250	°C/W
R _{th(c-h)}	热阻抗（壳至散）	180° 正弦波，单面散热				0.15	°C/W
V _{iso}	绝缘电压			2500			V
F _M	安装扭矩 (M5)				4		N·m
	安装扭矩 (M6)				6		N·m
T _{stq}	储存温度			-40		125	°C
W _t	质量						g
Outline	外形						



昆二晶整流器
KUNERJING

MFC、MFX、MFA、MTFK、SKKH 、MCD110A 普通/整流混合模块

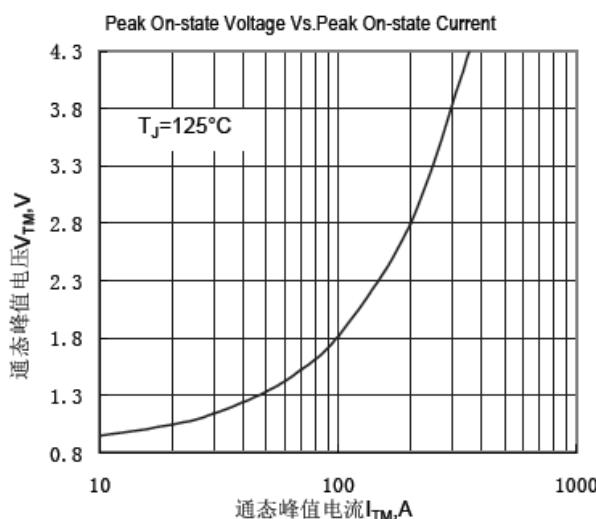


Fig.1 通态伏安特性曲线

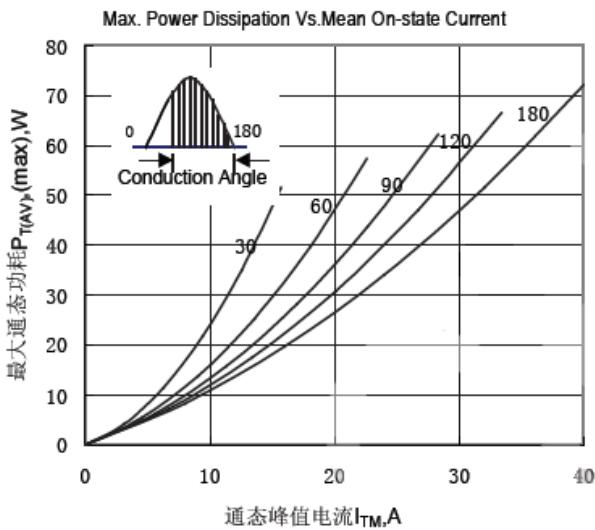


Fig.3 最大功耗与平均电流关系曲线

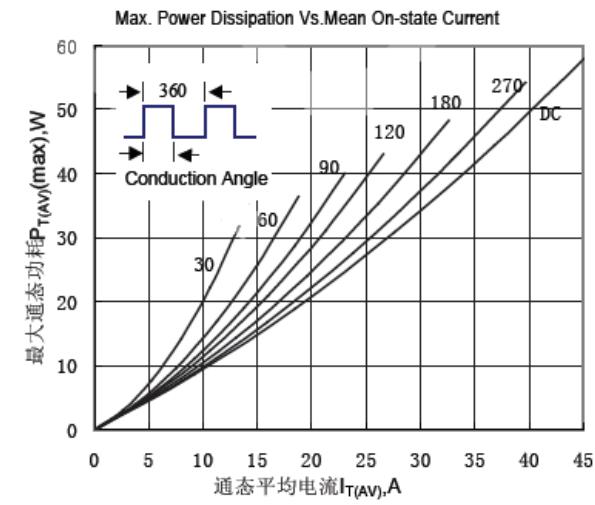


Fig.5 最大功耗与平均电流关系曲线

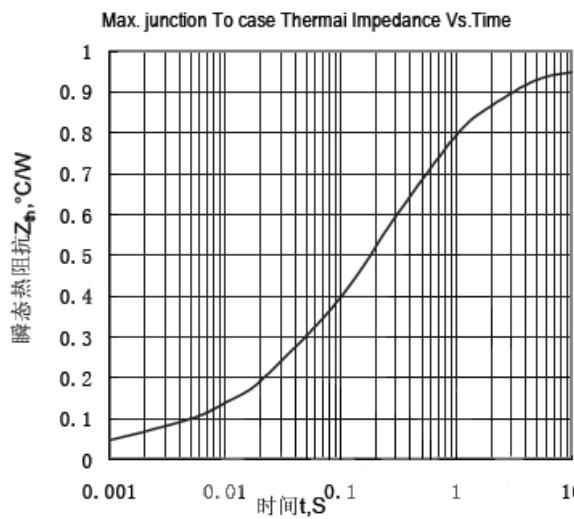


Fig.2 结至管壳瞬态热阻抗曲线

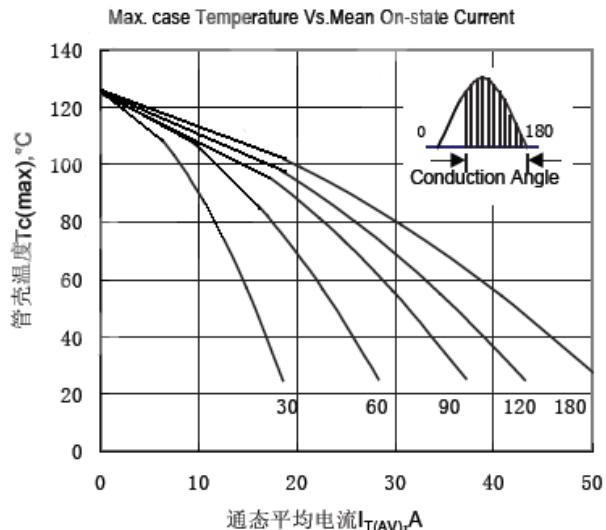


Fig.4 管壳温度与通态平均电流关系曲线

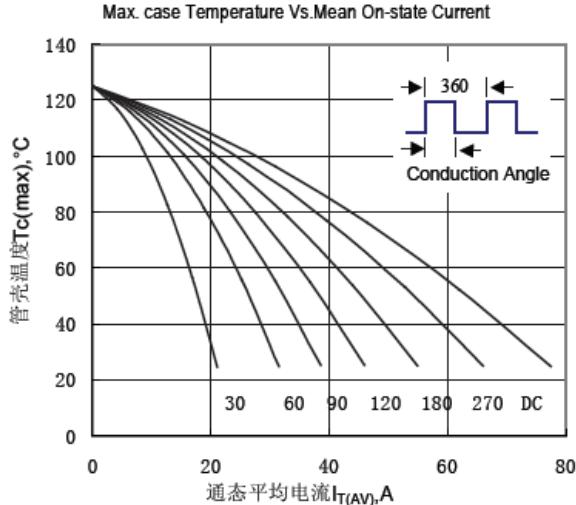


Fig.6 管壳温度与通态平均电流关系曲线



昆二晶整流器
KUNERJING

MFC、MFX、MFA、MFK、SKKH、MCD110A 普通/整流混合模块

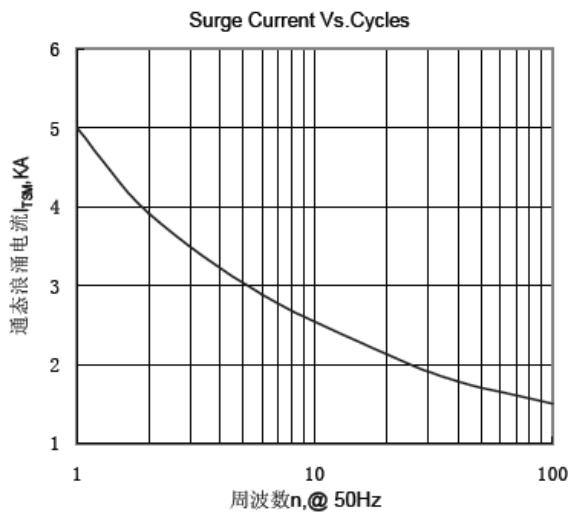


Fig.7 通态浪涌电流与周波数的关系曲线

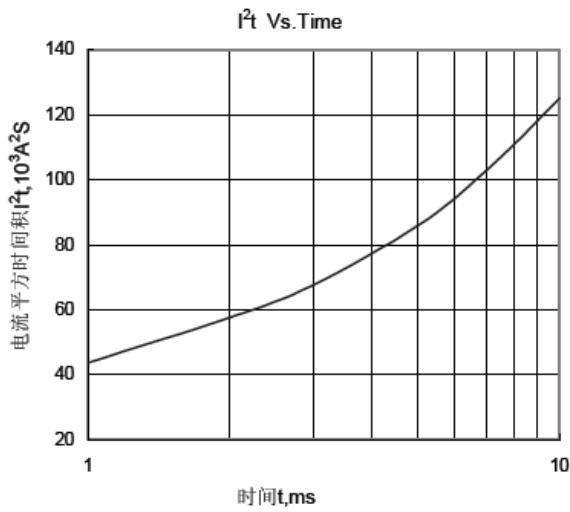


Fig.8 I^2t 特性曲线

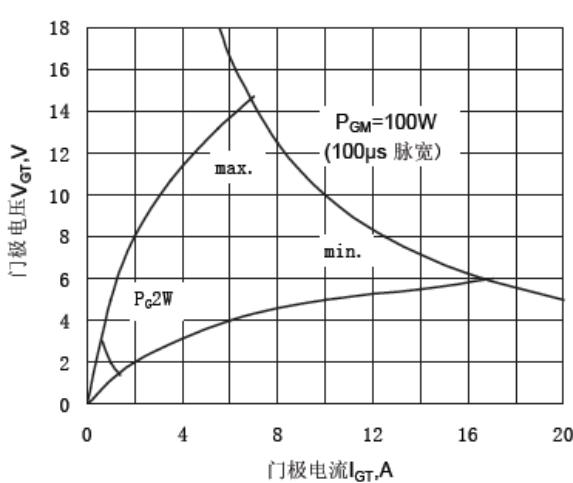


Fig.9 门极功率曲线

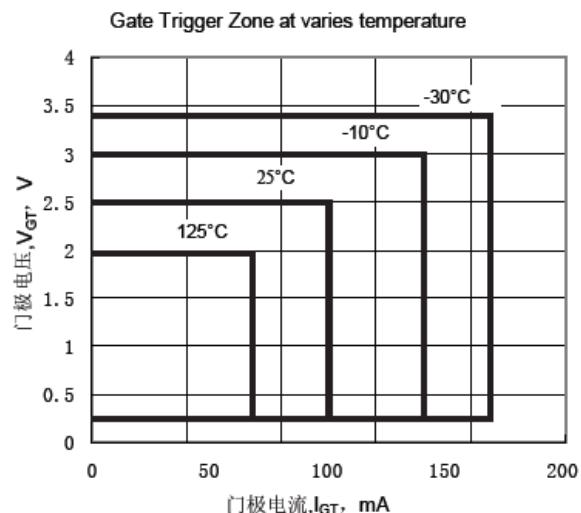
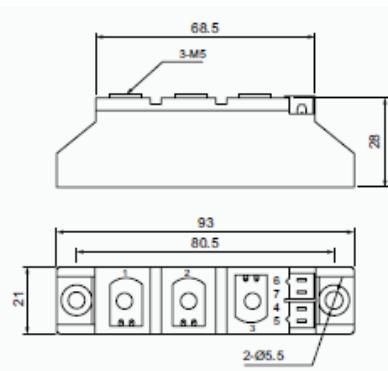
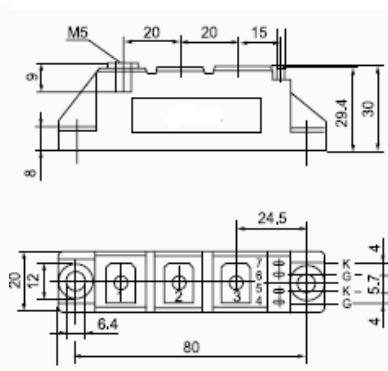
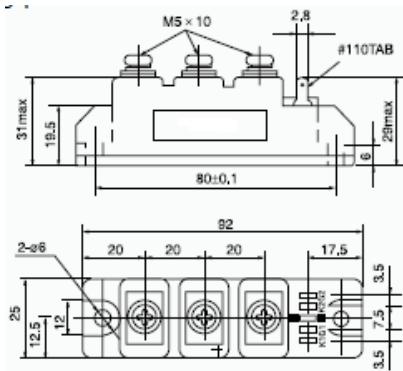


Fig.10 门极触发特性曲线

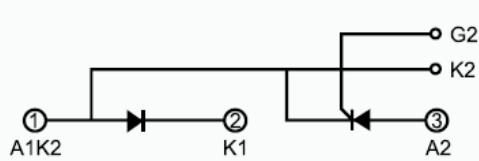
外形图：



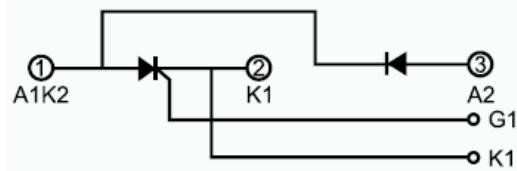


线路图：

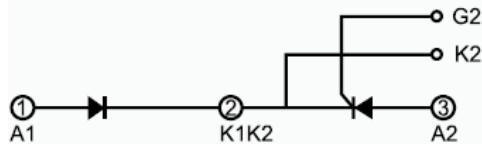
MFC(DT)



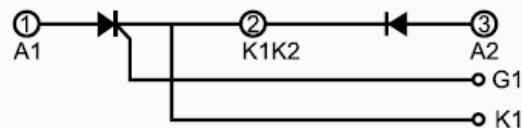
MFC(TD)



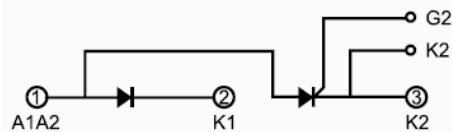
MFK(DT)



MFK(TD)



MFA(DT)



MFA(TD)

